Université Mohamed Boudiaf de M'sila Département d'Electronique Master II Microélectronique Optoélectronique

19/01/20

Contrôle continu n°1

Questions de cours (5points)

1/ Citer les trois processus d'interaction entre le rayonnement et le semi-conducteur d'énergie de gap Eg (bande interdite) ?

2/Donner un schéma synoptique d'un système de télécommunication à fibre optique ?

Exercice 1 (8points)

On rappelle la valeur des constantes universelles suivantes : $h = 6,63.10^{-34}$ J.s, c = 3.108 m.s $^{-1}$, $e = 1,6.10^{-19}$ C, $k = 1,38.10^{-23}$ J.K-1.

- 1. Rappeler la relation liant la longueur d'onde à la hauteur de la bande interdite dans un semiconducteur.
- 2. Quel est l'intérêt de réaliser un composé ternaire à base de Ga, As, Al en ce qui concerne la réalisation d'un composant optoélectronique ?
- 3. On désire réaliser une photodiode à partir de Al_x Ga_{1-x} As dont la longueur d'onde soit égale à 0,780 µm. Calculer la bande interdite correspond a cette longueur d'onde ?
- 4. Calculer la proportion x d'atomes d'aluminium sachant que la hauteur de la bande interdite est donnée par : $Eg(\mathbf{Al_x} \mathbf{Ga_{1-x}} \mathbf{As}) = 1,425 + 1,155.x + 0,37.x^2$ (en e.V).

Exercice 2 (7points)

2. On considère différents semi-conducteurs dont on rappelle les hauteurs de bandes interdites exprimées en e.V :

Ge	GaInAs	Si	AsGa	GaP
0,67	0,75	1,11	1,4	2,26

- 1. Déterminer les longueurs d'onde des différents semi-conducteurs?
- 2. Quel(s) seraient les matériaux appropriés pour réaliser une photodiode devant détecter une radiation lumineuse de longueur d'onde égale à 1,55 μm?
- 3. Expliquer pourquoi une diode émettrice (laser ou électroluminescente) nécessite une polarisation directe alors que pour une photodiode, la polarisation est inverse.



Opto électronique

Questions de cours

1/ Cours

2 Cours

Exercice 1

1. la relation liant la longueur d'onde à la hauteur de la bande interdite

$$\lambda = \frac{1.24.10^{-6}}{Eg[en \ e.V]}$$
 [m].

2. On peut ajuster λ et Eg en jouant sur les proportions des éléments (x et 1-x)

3. Eg=1,24
$$/0,78 = 1,589eV$$

4.
$$Eg(Al_xGa_{1-x}As) = 1,425 + 1,155.x + 0,37.x^2$$

$$1,589 = 1,425 + 1,155.x + 0,37.x^2 \implies x=0,137.$$

Exercice 2

Ge	GaInAs	Si	AsGa	GaP
0,67	0,75	1,11	1,4	2,26

1.
$$\lambda = 1,55$$
 E=1,24/1,55 E=0,8>=0,67 et 0,75 les matériaux sont **Ge et GaInAs**

2.
$$\lambda_{Ge} = 1.85$$
 $\lambda_{GaInAs} = 1.65$ $\lambda_{Si} = 1.11$ $\lambda_{AsGa} = 0.88$ $\lambda_{GaP} = 0.54$

3. Cours